Logika cyfrowa

Wykład 10: pamięć, układy programowalne

Marek Materzok

5 maja 2021

Pamięć

Pamięć

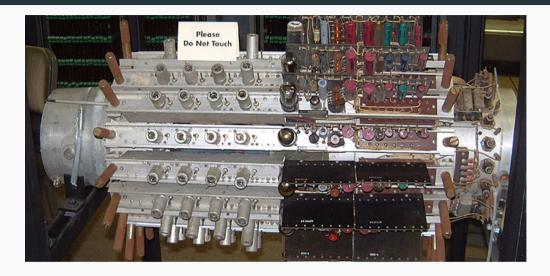
- Zbiór komórek pamięci indeksowanych adresami
- Tylko niewielka liczba komórek (typowo 1-3) obsługiwana równocześnie (w jednym cyklu układu synchronicznego)
- Układ używający pamięci musi "zlecać" dostępy w kolejnych cyklach

Rodzaje pamięci

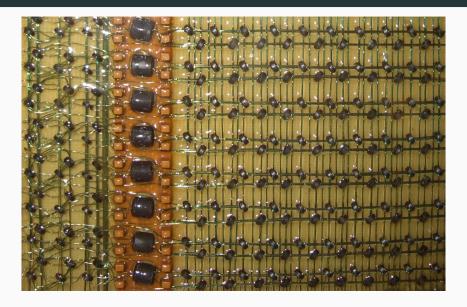
- Ulotne
 - SRAM (Static Random Access Memory)
 - DRAM (Dynamic Random Access Memory)
 - ...
- Nieulotne
 - ROM (Read Only Memory) tylko do odczytu
 - PROM (Programmable Read Only Memory) utrudniony, jednorazowy zapis
 - EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)
 - MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory)
 - PRAM (Phase-change Random Access Memory)
 - ...

Różne zasady działania, podobny interfejs

Pamięć rtęciowa (używana w latach 1947-53



Pamięć ferrytowa (core memory) używana w latach 1955-75

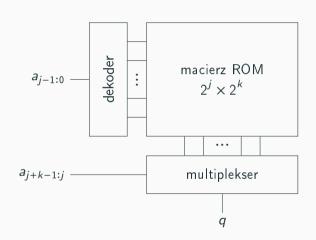


Pamięć ROM

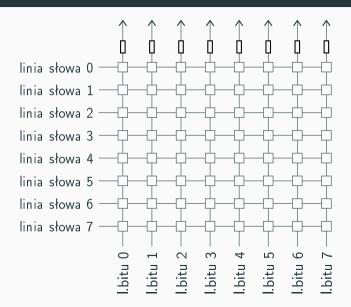
- Odwzorowanie n-bitowych adresów na m-bitowe wartości zakodowane w sposób nieulotny
- Funkcja boolowska $\mathbb{B}^n \to \mathbb{B}^m!$
- Możliwa implementacja układ kombinacyjny
 - Wada konieczność zaprojektowania nowego układu dla zmienionej zawartości
- Inne implementacje podyktowane redukcją kosztów

Organizacja pamięci ROM

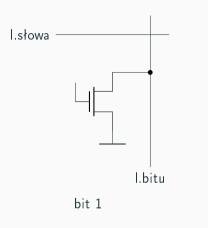
- Bity adresu dzielone między dekoder i multiplekser
- Dekoder wybiera wiersz
- Multiplekser wybiera kolumnę
- Wyjście q multipleksera odczytany bit



Macierz ROM



Mask ROM

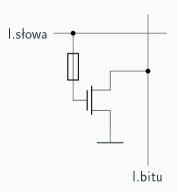


l.słowa l.bitu bit 0

Programowane w momencie produkcji układu

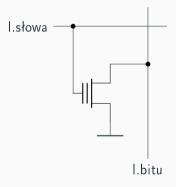
Programowalny ROM (PROM)

- W komórce element przepalany prądem
- Programowanie po wyprodukowaniu, przed montażem (np. podwyższonym napięciem)



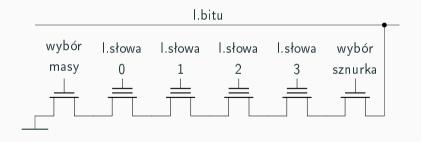
Kasowalny PROM (EPROM, EEPROM)

- Tranzystor z pływającą bramką
- Programowanie po wyprodukowaniu podwyższonym napięciem (tunelowanie)
- Kasowanie:
 - Ultrafioletem (EPROM)
 - Podwyższonym napięciem (EEPROM)



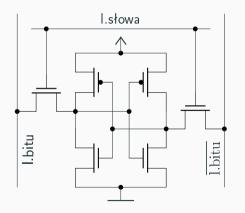
Pamięć flash

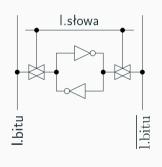
- NOR flash EEPROM kasowany blokami (np. 4k)
- NAND flash zwiększona gęstość przez połączenie tranzystorów w "sznurki"



Pamięć SRAM (statyczna)

Komórka – uproszczony przerzutnik asynchroniczny SR:

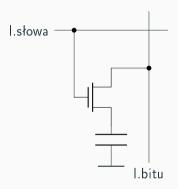




Pamięć DRAM (dynamiczna)

- Bit zapisany jako ładunek kondensatora
- Odczyt destruktywny (rozładowuje kondensator)
- Samoupływność, wymagane regularne odświeżanie

Prezentacja działania SRAM i DRAM: https://www.falstad.com/circuit/ Schematy / Układy sekwencyjne



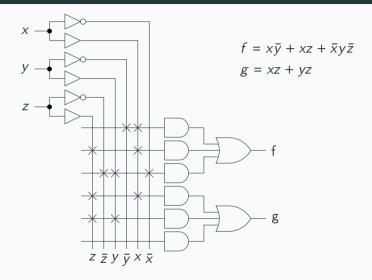
Układy programowalne

Rodzaje układów programowalnych (PLD)

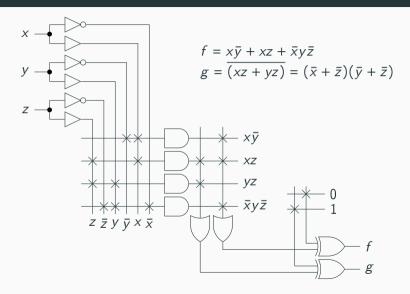
PLD - Programmable Logic Devices

- PROM zapis funkcji boolowskiej w formie tabelki
- PAL zapis funkcji w DNF, układ AND-OR o stałej strukturze
- PLA zapis funkcji w DNF, programowalny układ AND-OR
- CPLD układ programowalny z wbudowanymi przerzutnikami o prostej, gruboziarnistej strukturze
- FPGA układ programowalny z wbudowanymi przerzutnikami, o strukturze drobnoziarnistej siatki, logiką kombinacyjną w postaci LUT (Look-Up Table) RAM

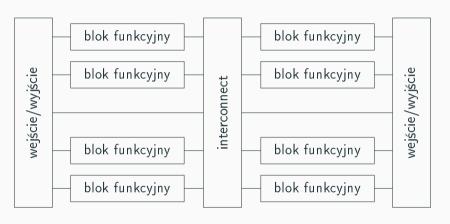
PAL – Programmable Array Logic



PLA - Programmable Logic Array

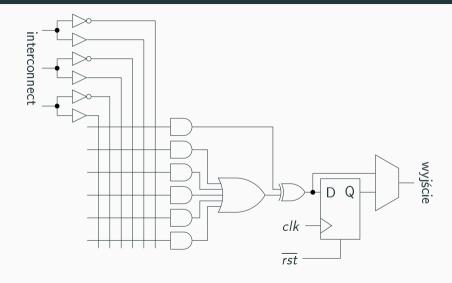


CPLD - Complex Programmable Logic Device

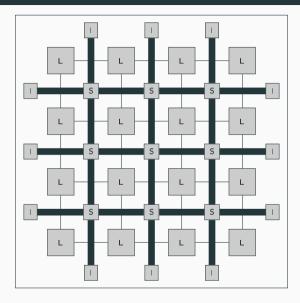


Bloki funkcyjne typowo zawierają kilkanaście makrokomórek.

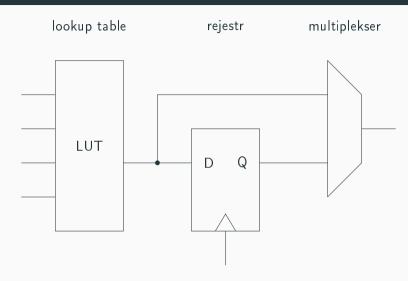
Makrokomórka CPLD – przykład



FPGA – Field Programmable Grid Array



Blok logiczny FPGA – przykład



Pamięć w SystemVerilogu

Tablice w SystemVerilogu

• Zakres napisany za identyfikatorem definiuje tablicę:

```
logic [7:0] mem [0:255]; // 256 bajtów
```

- Tablice w Verilogu są jednowymiarowe.
 SystemVerilog dopuszcza tablice wielowymiarowe, ale Yosys ich nie obsługuje ©
- Tablice w SystemVerilogu wykorzystuje się do opisywania pamięci zgodnie z zaprezentowanymi później idiomami.

Inicjalizacja

Elementy pamięciowe można inicjalizować w bloku initial:

```
logic x;
initial x = 0;
```

Inicjalizacja

Elementy pamięciowe można inicjalizować w bloku initial:

```
logic x;
initial x = 0;
```

• Inicjalizacja dla przerzutników (typowo) nie jest syntezowalna. Należy wprowadzić sygnał reset, gdy inicjalizacja jest konieczna.

Inicjalizacja

Elementy pamięciowe można inicjalizować w bloku initial:

```
logic x;
initial x = 0;
```

- Inicjalizacja dla przerzutników (typowo) nie jest syntezowalna. Należy wprowadzić sygnał reset, gdy inicjalizacja jest konieczna.
- Inicjalizacja dla pamięci ROM/RAM dla niektórych technologii (np. niektóre FPGA) jest syntezowalna.

Inicjalizacja¹

Elementy pamięciowe można inicjalizować w bloku initial:

```
logic x;
initial x = 0;
```

- Inicjalizacja dla przerzutników (typowo) nie jest syntezowalna. Należy wprowadzić sygnał reset, gdy inicjalizacja jest konieczna.
- Inicjalizacja dla pamięci ROM/RAM dla niektórych technologii (np. niektóre FPGA) jest syntezowalna.
- Pamięci nie można resetować! Użycie sygnału reset do czyszczenia pamięci spowoduje wygenerowanie osobnego rejestru dla każdej komórki pamięci.

Inicjalizacja pamięci

```
Przykład - zerowanie:
integer i;
logic [7:0] mem [0:255];
initial
    for (i = 0; i < 256; i = i+1)
        mem[i] = 0;</pre>
```

Inicjalizacja plikiem obrazu

Format pliku:

```
logic [7:0] mem [0:255];
initial $readmemh("image.hex", mem); // szesnastkowy
// albo:
initial $readmemb("image.bin", mem); // binarny
```

- Liczby szesnastkowe/binarne, jedna liczba na komórkę
- Oddzielone białymi znakami lub komentarzami
- Adresy postaci @hh...h liczba szesnastkowa poprzedzona małpą

Dostępy do pamięci

- Każda operacja dostępu do pamięci jest rozumiana jako dodatkowy port (do odczytu lub zapisu).
 - SystemVerilog nie zabrania wprowadzić dowolnie wielu portów,
 ALE rzeczywiste pamięci mają zwykle jeden do dwóch.
- Odczyty w blokach kombinacyjnych definiują odczyt asynchroniczny (niezależny od zegara).
 assign out = mem[addr];
- Odczyty i zapisy w blokach always_ff definiują odczyt lub zapis synchroniczny (odbywający się po zboczu zegarowym).

```
always_ff @(posedge clk) mem[addr] <= in;</pre>
```

Pamięć ROM

```
module memory(
    input [5:0] addr,
    output [3:0] out
);
    logic [3:0] mem [0:63];
    assign out = mem[addr];
    initial $readmemh("image.hex", mem);
endmodule
```

Pamięć RAM z asynchronicznym odczytem

```
module memory(
    input wr, clk,
    input [5:0] addr,
    input [3:0] in,
    output [3:0] out
);
    logic [3:0] mem [0:63];
    assign out = mem[addr];
    always_ff @(posedge clk)
        if (wr) mem[addr] <= in;</pre>
endmodule
```

Pamięć RAM z synchronicznym odczytem (jeden port odczyt/zapis)

```
module memory(
    input wr, clk,
    input [5:0] addr,
    input [3:0] in,
    output [3:0] out
);
    logic [3:0] mem [0:63];
    always_ff @(posedge clk)
        if (!wr) out <= mem[addr]:
    always_ff @(posedge clk)
        if (wr) mem[addr] <= in:</pre>
endmodule
```

Pamięć RAM z s.o. dwuportowa (R+W)

```
module memory(
    input rd, wr, clk,
    input [5:0] rdaddr, wraddr,
    input [3:0] in,
    output [3:0] out
);
    logic [3:0] mem [0:63];
    always_ff @(posedge clk)
        if (rd) out <= mem[rdaddr]:</pre>
    always_ff @(posedge clk)
        if (wr) mem[wraddr] <= in:
endmodule
```

Pamięć RAM asynchroniczna trójportowa (R+R+W)

```
module memory(
    input wr, clk,
    input [5:0] rdaddr1, rdaddr2, wraddr,
    input [3:0] in,
    output [3:0] out1, out2
);
    logic [3:0] mem [0:63];
    assign out1 = mem[rdaddr1];
    assign out2 = mem[rdaddr2];
    always_ff @(posedge clk)
        if (wr) mem[wraddr] <= in:
endmodule
```

Pamięć RAM asynchroniczna trójportowa (R+W+W)

```
module memory(
    input wr1, wr2, clk,
    input [5:0] rdaddr, wraddr1, wraddr2,
    input [3:0] in1, in2,
    output [3:0] out
);
    logic [3:0] mem [0:63];
    assign out = mem[rdaddr];
    always_ff @(posedge clk) begin
        if (wr1) mem[wraddr1] <= in1:</pre>
        if (wr2) mem[wraddr2] <= in2;</pre>
    end
endmodule
Uwaga - niezdefiniowane zachowanie gdy wraddr1 == wraddr2
```

Pamięci – podsumowanie

- Odczyt może być asynchroniczny (w bloku assign lub always_comb) lub synchroniczny (always_ff).
- Zapisy tylko synchroniczne!
- Każdy odczyt i zapis z tablicy oznacza wprowadzenie dodatkowego portu pamięci.
 - Uwaga: w przypadku wspólnego adresu do odczytu i zapisu, mówi się o jednym porcie do odczytu lub zapisu.
- Pamięci o więcej niż dwóch portach są w praktyce rzadko spotykane. Typowa pamięć jest jednoportowa.
- Zalecam specyfikowanie pamięci w osobnym module.

Projektowanie układów z pamięcią

Przykład 1 – układ sumujący zawartość pamięci

- Będziemy sumować zawartość pamięci ROM zawierającej 16 liczb 12-bitowych
- 1 port do odczytu (asynchronicznego): 4 bity adresu, 12 bitów wyjścia
- Ponieważ możliwy jest odczyt jednej komórki w cyklu, potrzebny jest stan, aby:
 - Generować kolejne adresy (4 bity)
 - Wiedzieć, że skończyliśmy (1 bit)
 - Pamiętać wynik pośredni (12 bitów)
- Pamięć ROM z asynchronicznym odczytem można traktować jak układ kombinacyjny
- Wejścia i wyjścia układu:
 - Wejście 1-bitowe start rozpoczęcie sumowania
 - Wyjście 1-bitowe fin koniec sumowania (wynik poprawny)
 - Wyjście 12-bitowe out wynik

Projektowanie układu dla przykładu 1 – transfer rejestrów

- Potrzebne rejestry:
 - Akumulator 12-bitowy acc oblicza sumę
 - Licznik 4-bitowy cnt odlicza adresy ROM
 - Bit końca fin
- Model odczytu asynchronicznego pamięci:
 - $\bullet \ \mathsf{val}_t = \mathsf{mem}[\mathsf{addr}_t]$

Projektowanie układu dla przykładu 1 – transfer rejestrów

Odczyt pamięci: $val_t = mem[cnt_t]$ (w module pamięci)

Kiedy start $_{t-1} = 1$:

- $cnt_t \leftarrow 0$
- $acc_t \leftarrow 0$
- $fin_t \leftarrow 0$

 $\mathsf{Kiedy}\ \mathtt{start}_{t-1} = 0\ \mathsf{i}\ \mathtt{fin}_{t-1} = 0$

- $\operatorname{cnt}_t \leftarrow \operatorname{cnt}_{t-1} + 1$
- $\bullet \ \mathtt{acc}_t \leftarrow \mathtt{acc}_{t-1} + \mathtt{val}_{t-1}$
- $fin_t \leftarrow cnt_{t-1} = 15$

W przeciwnym wypadku brak zmian wartości rejestrów.

Przykład 1 – System Verilog

```
module sum rom(
  input clk, start,
  output logic fin,
  output [11:0] out
  logic [3:0] cnt;
  logic [11:0] acc, val;
  // ROM asynchroniczny
 rom mem(cnt, val);
  assign out = acc;
```

```
always_ff @(posedge clk)
    if (start) begin
      cnt <= 4'b0;
      acc <= 12'b0;
     fin <= 1'b0:
    end else if (!fin) begin
     cnt <= cnt + 1;
      acc <= acc + val:
     fin <= cnt == 15:
    end
endmodule
```

Przykład 1 – wykonanie

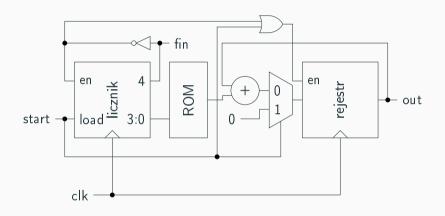
Przyjmijmy, że pamięć zawiera pierwsze 16 elementów ciągu Fibonacciego.

cykl	start	cnt	val	acc	fin
1	1	Х	Х	Х	Х
2	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0
4	0	2	1	1	0
5	0	3	2	2	0
:	:	:	:	:	:
16	0	14	377	609	0
17	0	15	610	986	0
18	0	0	0	1596	1
19	0	0	0	1596	1

Projektowanie układu dla przykładu 1 – inne podejście "układowe"

- Adresy: licznik 5-bitowy
 - najstarszy bit oznacza koniec sumowania
- Wynik pośredni: sumator wielocyklowy
 - Inicjalizacja synchroniczna na 0

Przykład 1 – układ sumujący zawartość pamięci



$\label{eq:conversion} {\sf Przykład} \ 1 - {\sf SystemVerilog}, \ {\sf podej\acute{s}cie} \ \text{\tt ,układowe}"$

```
module sum rom(
    input clk, start,
    output fin,
    output [11:0] out
    logic [3:0] addr;
    logic [11:0] val;
    logic en:
    assign en = !fin;
    counter cnt(clk, en, start, {fin, addr});
    register re(clk, start || en,
        start ? 12'b0 : out + val, out);
    rom mem(addr, val);
endmodule
```

Przykład 2 – układ sumujący ROM z odczytem synchronicznym

- Pamięć synchroniczna jest taktowana zegarem
- Wynik dostępu do pamięci dostępny w kolejnym cyklu zegara (po zboczu zegarowym)
- Model: dodatkowy rejestr za pamięcią z odczytem asynchronicznym
 - $val_t \leftarrow mem[addr_{t-1}]$
- Należy skonstruować układ, aby "odebrał" wartość cykl po wykonaniu dostępu
- Spostrzeżenie: jeśli wyślemy adres cykl wcześniej, logika sterujące może pozostać bez zmian

Projektowanie układu dla przykładu 2 – transfer rejestrów

Nową wartość adresu możemy obliczyć kombinacyjnie:

•
$$newcnt_t = start_t \lor fin_t ? 0 : cnt_t + 1$$

Pamięć adresujemy nowym adresem:

•
$$val_t \leftarrow mem[newcnt_{t-1}]$$
 (w module pamięci)

Aktualizujemy licznik nowym adresem:

•
$$cnt_t \leftarrow newcnt_{t-1}$$

Logika dla acc i fin bez zmian

Przykład 2 – System Verilog

```
module sum_rom_sync(
                                          always_ff @(posedge clk)
  input clk, start,
                                           cnt <= newcnt:</pre>
  output logic fin,
                                          always ff @(posedge clk)
  output [11:0] out
                                           if (start) begin
                                             acc <= 12'b0:
  logic [3:0] cnt, newcnt;
                                             fin <= 1'b0:
  logic [11:0] acc, val;
                                           end else if (!fin) begin
  // ROM synchroniczny
                                             acc <= acc + val:
  rom_sync mem(clk, newcnt, val);
                                             fin \ll cnt == 15:
  assign newcnt =
                                           end
    start | fin ? 0 : cnt + 1; endmodule
  assign out = acc;
```

Przykład 2 – wykonanie

Zauważmy, że val uzyskuje wartość dla newcnt po cyklu.

cykl	start	cnt	newcnt	val	acc	fin
1	1	Х	0	Х	Х	Х
2	0	0	1	0	0	0
3	0	1	2	1	0	0
4	0	2	3	1	1	0
5	0	3	4	2	2	0
:	:	:	:	:	:	:
16	0	14	15	377	609	0
17	0	15	0	610	986	0
18	0	0	0	0	1596	1
19	0	0	0	0	1596	1

Przykład 3 – układ obliczający wartości bezwzględne

- Będziemy zamieniać wszystkie wartości zapisane w RAM (16 liczb 8-bitowych ze znakiem) na ich wartość bezwzględną.
- 1 port do odczytu asynchronicznego: 4 bity adresu, 8 bitów wyjścia
- 1 port do zapisu: 8 bitów wejścia, 1 bit enable, adres wspólny z odczytem
- Zapis jest synchroniczny: następuje na zboczu zegarowym (tak jak zapisy do rejestrów)
- Wejścia i wyjścia układu:
 - Wejście 1-bitowe start rozpoczęcie sumowania
 - Wyjście 1-bitowe fin koniec sumowania (wynik poprawny)

Projektowanie układu dla przykładu 3 – transfer rejestrów

- Potrzebne rejestry:
 - Licznik 4-bitowy cnt odlicza adresy RAM
 - Bit końca fin
- Wyniki wartości bezwzględne będą zapisywane w pamięci w kolejnym cyklu po ich odczytaniu. Model zapisów synchronicznych:
 - $\bullet \ \mathtt{mem}_t [\mathtt{addr}_{t-1}] \leftarrow \mathtt{data}_{t-1}$

Projektowanie układu dla przykładu 3 – transfer rejestrów

Odczyt pamięci: $val_t = mem_t[cnt_t]$ (w module pamięci)

Zapisujemy pamięć tylko, gdy odczytana liczba jest ujemna:

•
$$wr_t = val_t < 0$$

Zapisywana wartość jest przeciwna do odczytanej:

• $data_t = -val_t$

 $\mathsf{Zapis}\;\mathsf{pamięci} \colon \mathtt{mem}_t \big[\mathtt{cnt}_{t-1}\big] \leftarrow \mathtt{data}_{t-1}\; \big(\mathsf{w}\;\mathsf{module}\;\mathsf{pamięci}\big)$

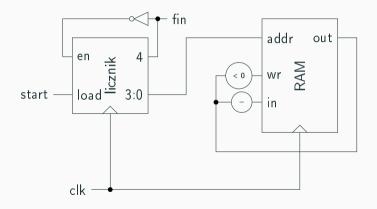
Logika dla cnt i fin jak w przykładzie 1.

Przykład 3 – System Verilog

```
module abs ram(
  input clk, start,
  output logic fin,
  output signed [7:0] val
  logic [3:0] cnt;
  logic [7:0] data = -val;
  logic wr = val < 0;</pre>
  ram mem(clk, wr, cnt,
    data, val);
```

```
always_ff @(posedge clk)
    if (start) begin
      cnt <= 4'b0:
      fin <= 1'b0;
    end else if (!fin) begin
      cnt <= cnt + 1;
      fin \ll cnt == 15:
    end
endmodule
```

Przykład 3 – podejście "układowe"



Przykład 3 – System Verilog, podejście "układowe"

```
module abs ram(
    input clk, start,
    output fin,
    output signed [7:0] val
);
    logic [3:0] addr;
    logic en;
    assign en = !fin;
    counter cnt(clk, en, start, {fin, addr});
    ram mem(clk, val < 0, addr, -val, val);
endmodule
```